多重散乱光の干渉による光記録効果における ホールの深さについて

栗田 厚、兼松 泰男、櫛田 孝司^A

大阪大学 大学院理学研究科 物理学専攻 (〒 560-0043 豊中市待兼山町 1-1) 奈良先端大 物質創成科学研究科 A (〒 630-0101 生駒市高山町 8916-5)

On the hole depth of optical memory effect by interference of multiple-scattered light

A. Kurita, Y. Kanematsu, T. Kushida^A

Department of Physics, Osaka University Department of Materials Science, NAIST ^A

Abstract

Our recent experiments have shown that both the wavelength and the angle of incident light are memorized in Sm-doped ZnS nanocrystals by photobleaching coupled with interference of the multiple-scattered light. Here we show generality of this effect by experiments on polystyrene powder doped with fluorescent photochromic fulgide and discuss the hole depth of this effect

1. はじめに

昨年、我々は、Sm を添加した ZnSナノ結晶に おいて、新規な光記録効果を発見した¹⁻³。この 効果は、蛍光の励起スペクトル上で観測され、試 料に単色光を照射すると、その後、励起スペク トルに永続的な凹み(ホール)が残るという形で 見出された。この結果だけ見ると、これは永続 的ホールバーニング効果⁴のように見える。しか しこのホールは、読み出し光(蛍光を励起する光) の波長のみでなく、入射角も書き込み光のそれと 一致したときのみ、観測された。これは、この効 果の機構が従来の永続的ホールバーニングとは 全く異なるものであることを意味する。

我々は、その機構が以下のようなものであることをに明らかにした。

ナノ結晶中では、屈折率の空間的不均一性があ るため、これに入射した光は何度も散乱される (多重散乱)。その結果、媒体中には、さまざま な光路を経た散乱光同志の干渉によって、スペッ クルのようなランダムな明暗模様ができる。この 干渉パターンは入射光の波長と角度によって異な るが、これがSmイオンの光化学反応によって、 吸収強度の空間的変化として記録される。記録の 読み出しの際は、たとえば光の波長を掃引しなが ら照射し、Smイオンの発光強度を測定する。す ると、読み出し光の波長が記録光の波長と一致 した時に、干渉によって読み出し光の強度が強く なっている場所では、書き込みの際の光化学反応 によって吸収強度が弱くなっているため、発光強 度が、ほかの波長の光を照射したときよりも減少 する。そのため、強いレーザー光を照射した後、 その周囲の波長でSmの発光の励起スペクトルを 測定すると、照射した波長を中心とするホールが 観測される。干渉パターンが入射角によっても変 化するため、ホールの深さは読み出し光の入射角 にも依存する。

この効果は、光化学反応を起こす物質と光の 多重散乱体を組み合わせれば、無機・有機を問わ ず、多くの物質で一般的に起きることが、その機 構から期待される。そこで我々は、光化学反応材 料として、フォトクロミズムを示すフルギド分子 を用い、それをポリスチレンによる散乱体に入れ た記録媒体を設計し、ZnSナノ結晶中のSmの場 合と同じ効果を観測し、この効果の一般性を確か めた。ここではその実験結果と、ホールの深さに 関して行なった考察について述べる。

2. 実験方法

フルギドがフォトクロミズムを示すことはよ く知られているが、我々の実験では蛍光によって ホールを測定するので、光反応を起こすだけでな く、蛍光を出す材料が必要である。室温で蛍光を 出すフォトクロミズム分子は多くないが、フルギ



図 1: ポリスチレン粉末中のフルギドの、514.5nm 0.8mW のレーザー光照射による蛍光強度の時間 変化。

ドの誘導体の一つでは蛍光が観測されている5。 フルギドは、2つの異性体を持つ。500 nm 付近 に吸収のピークを持つC体と、紫外域に吸収を持 つE体で、それぞれが吸収する光を照射すると、 相互に可逆的に変換される。それぞれの状態は、 熱的には安定である。蛍光性の誘導体では、C体 のみが蛍光を出す。したがって、C体から出発す ると、光照射によってE体への変換が起こり、そ れとともに蛍光強度が減少する。このフルギド 誘導体を入れたポリスチレン・フィルムを微粉末 状にし、試料とした。走査型電子顕微鏡で粉末 試料を観察すると、1 μm 以下のスケールの構造 が見られ、可視光に対して有効な散乱体となって いると考えられる。実際、コヒーレント後方散 乱を測定すると、Sm を添加した ZnS ナノ結晶の 場合1-3と同程度の幅の後方散乱ピークが観測さ れ、試料中の光の平均自由行程が同程度に短いこ とがわかった。

試料は、上向きにしたミラーホルダーに取りつ けたガラス板の上に載せた。ミラーホルダーに は、コンピューター制御されたマイクロメーター (シグマ光機 オプトマイク)を取り付け、これに よって試料ホルダーの法線と入射光との間の角度 を、最小分解能 0.0023°で連続的に掃引した。

3. 実験結果

ポリスチレン粉末中のフルギドの 500 nm 付近 の吸収帯にレーザーを照射しながら、600 nm 付 近の蛍光が減少していく様子を測定した結果を 図 1に示す。途中で蛍光強度がゼロになっている ところは、レーザー光の照射を一旦止めたところ である。再び照射を始めると、蛍光強度は照射を 止める直前と全く同じ強度から再び減少をはじ



図 2: ポリスチレン粉末中のフルギドに 488nm 0.85mWのレーザー光を照射し、角度掃引によっ て測定したホール形状。右側の数字は、積算した 光照射時間。

め、生成状態(E体)が安定であることがわかる。 なお、ZnSナノ結晶中のSmの場合は、照射を止 めると反応の戻りがかなり見られた。フルギド は、反応の戻りがないため、光照射後のスペクト ル変化を測定し、その後また引き続き光照射をし てさらに変化したスペクトルを測定するという 実験から、定量的な知見を得るのに適している。 図2に、照射時間を延ばしていったときのホール 形状の変化を示す。このように、角度掃引によっ てホールが観測されるということは、このホー ルが、ZnSナノ結晶中のSmと同様の、多重散乱 光の干渉によって生じていることを示している。 ホール幅は、途中までは少し狭くなっていくが、 その後は一定で、照射時間を長くしても通常の ホールバーニングのように飽和によって広がると いうことはない。最初狭くなるのは、フルギドの 吸収が減少するために光が試料中を長距離拡散 できるようになり、干渉する光の光路差が長くな るためと考えられる。照射時間とともに、ホール の底での発光強度は減少していくが、ホールの両 側の平らな部分の全体的な減少もあるため、ホー

ルの深さの方は、ある照射時間のところで最大と なり、その後減少している。この実験結果を、次 に考察する。

4. ホール深さの理論的考察

試料内での書き込み光強度の空間分布を、位置 rの関数としてI(r)と書く。I(r)によって光反 応が引き起こされ、吸収係数の変化が起きるとす ると、rにおける局所的吸収係数は、I(r)と照射 時間 t_b の積の関数として一般に $a(I(r)t_b)$ と書 ける。吸収係数が照射光量の指数関数の形で減少 する場合は、

$$a(I(r)t_b) \propto \exp(-I(r)t_b)$$
 (1)

であり、以後この場合を扱う。ただし、簡単のた め、反応の断面積などの定数が省略されるように 単位系を選んだことにした。このように吸収係数 が空間的に変調された試料に、読み出し光を照射 して蛍光を励起したときの、蛍光強度を考える。 読み出し光の空間分布をI'(r)と書き、局所的な 蛍光強度が、局所的な吸収係数と励起光強度の 積に比例するとすれば、試料全体からの蛍光強度 $F(t_b)$ は、

$$F(t_b) = \int \exp(-I(r)t_b) I'(r) dr$$

で与えられる。積分は、試料全体での空間積分で ある。読み出し過程で、読み出し光の波長や入射 角を掃引すると、それに従ってI'(r)が変化する。 ホールの中心では、読み出し光の波長と入射角が 書込み光のそれらと同一なので、I'(r) = I(r)と なる。一方、読み出し光の波長などが書き込みの 時の条件から十分に離れている場合は、書込み光 と読み出し光の試料内での空間分布は互いに独 立と考えられ、 $I \ge I'$ の積分を分離することがで きる。したがって、図2に示すように、ホールの 中心での蛍光強度を F_h 、ホールから十分に離れ たフラットな部分での蛍光強度を F_f とすると、 それらは

$$F_h(t_b) = \int e^{-I(r)t_b} I(r) dr$$

$$F_f(t_b) = \int e^{-I(r)t_b} dr \int I'(r) dr$$

となる。ただし、厳密には、空間分布は散乱体の 構造にも依存するはず(たとえば、散乱体の界面 付近では、入射光の条件によらず、常に強くなり やすい、等)なので、 $I(r) \ge I'(r)$ は完全に独立 にはならないであろう。

 $I(r) \ge I'(r)$ の具体的な形は未知であるが、その分布確率 P(I)がわかれば、空間積分は、P(I)



図 3: ホールの中心(破線)、フラット部分(実線)、 ホール深さ(点線)の時間発展(式(2),(3))。

で重みづけした *I* による積分で置き換えられる。 $\int_0^\infty \cdots P(I) dI \ \epsilon \langle \cdots \rangle \ \epsilon$ 書くと、 $F_h \ \epsilon \ F_f \ t$

$$F_h(t_b) = \langle e^{-I \cdot t_b} \cdot I \rangle$$

$$F_f(t_b) = \langle e^{-I \cdot t_b} \rangle \langle I \rangle$$

で求められる。 $F_h \ge F_f$ は、光照射前には1で あるように規格化した。

P(I)は、レーザースペックルの強度分布⁶と同 じように、次のような考察から見積もることが できる。試料中のある点における電場を考える。 入射光は、いくつかの散乱経路を通ってここに到 達する。したがって、その電場は、各散乱経路を 通ってきた数多くの光の電場の和で作られる。各 電場の位相は互いにランダムであるとすると、電 場を複素数で表わした場合、電場の和は複素空間 中でランダムな方向を向いた多数のベクトルの和 となり、その分布はガウス分布となる。これを強 度Iの分布に焼き直すと、強度の平均値を I_0 と して、分布関数は $P(I) = (1/I_0) \exp(-I/I_0)$ に なる。以後、 $I_0 = 1$ とする。 このP(I)を用いると、

$$F_h(t_b) = \frac{1}{(1+t_b)^2}$$
(2)

$$F_f(t_b) = \frac{1}{1+t_b} \tag{3}$$

となる。ホールの深さはこれらの差であるから、

$$F_f(t_b) - F_h(t_b) = \frac{t_b}{(1+t_b)^2}$$

である。 $F_h(t_b)$, $F_f(t_b)$, $F_f(t_b) - F_h(t_b)$ を図3 に示す。 $F_f - F_h$ は $t_b = 1$ のとき最大となり、 そのとき $F_f(1) - F_h(1) = 0.25$ 、 $F_f(1) = 0.5$ で ある。つまり、ホールから離れたところでの蛍光 強度が光照射前の半分になるまでホールをあけ ると、ホールはもっとも深くなり、その深さは、 フラットな部分の蛍光強度の半分となる。フルギ ドにおける図2の実験結果は、定性的にはこのモ デルで説明される。

光照射時間が十分に短い極限 $t_b \ll 1$ では、

$$F_h(t_b) = 1 - 2 t_b$$

$$F_f(t_b) = 1 - t_b$$

であるので、全体的な減少とホールの深さの比は、 1:1 であることがわかる。この比を、鏡によって 作られる定在波による空間的ホールバーニングに よるホールの深さの比^{1,3}と比較してみる。反射 率100%の鏡で変調の深さが100%(谷の部分で光 強度がゼロになる)の定在波が作られた場合、光 の進行方向の座標を z、光の波数を k とすると、 光強度は $I(z) = 1 - \cos(2kz)$ と書ける (I の平 均値は 1 とした)。この場合、強度の分布は

$$P(I) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{I(2-I)}} \quad (0 \le I \le 2)$$

になるので、 $t_b \ll 1$ の場合は

$$F_h(t_b) = 1 - \frac{3}{2}t_b$$

$$F_f(t_b) = 1 - t_b$$

となる。したがって、全体的な減少とホールの深 さの比は、2:1 になる。すなわち、反射率100%の 鏡で作られた定在波より、ランダムな散乱によっ て作られた干渉パターンの方が、相対的に深い ホールを与える。

一方、光照射時間が長い極限で、フラットな部 分の蛍光強度に対するホールの深さの比を考える。 これは $(F_f(t_b) - F_h(t_b))/F_f(t_b) = t_b/(1+t_b)$ に なるので、 $t_b \to \infty$ で 1 に近づく。つまり、蛍光 強度が十分に強ければ、ホールの底が蛍光強度ゼ 口まで切れ込んだ、100%の深さに近いホールが 観測されるはずである。ただし、実際は光反応に よって蛍光が完全になくなるところまでは行かな い $(a(I \cdot t_b)$ が $t_b \to \infty$ でゼロにならない) ため、 一定強度のバックグラウンドが残る場合が多いで あろう。

多重散乱体の試料に強い光を照射しながら、光 反応によって蛍光が時間 t とともに減衰する過程 を測定することは、記録光が読み出し光を兼ねて いるので、I(r) = I'(r)の場合に相当し、 $F_h(t)$ がその測定結果に対応する。式(2)から、光反応 自体は指数関数的な時間依存性(式(1))を示すも のでも、干渉による光強度の空間的不均一性のた めに、見かけの時間依存性は $1/(1 + t)^2$ になる ことがわかる。逆に、 $a(I \cdot t)$ と $F_h(t)$ を精密に 測定したら、媒体内での光強度の分布確率 P(I)を実験的に求めることができる。ただし、フル ギドの場合は、フィルム状の試料で $a(I \cdot t)$ を実 測した結果は、指数関数とは大きく異なり、ほ ぼ $1/\sqrt{1+t}$ に乗った。この場合、上記の手法で $F_h(t)$ を求めると、これも $1/\sqrt{1+t}$ に近い形に なることがわかり、実際、図1の結果は $1/\sqrt{1+t}$ でフィットできた。このため、フルギドを用いた 実験で P(I)を求めるのは困難であろう。

最後に、多数のホールをあけた場合を考える。 まず、2つのホールをあけた場合、それぞれの書 き込み時の強度分布を $I_1(r)$, $I_2(r)$ とし、光反応 は照射した光の総量で決まるとすると、

$$F = \int e^{-(I_1(r) + I_2(r)) \cdot t_b} I'(r) dr$$

と書ける。 $I_1(r)$ と $I_2(r)$ は互いに独立であると すると、ホールの中心では $I_1(r) = I'(r)$ または $I_2(r) = I'(r)$ であるので、

$$F_h(t_b) = \langle e^{-I \cdot t_b} \cdot I \rangle \langle I \rangle = \frac{1}{(1+t_b)^3}$$
$$F_f(t_b) = \langle e^{-I \cdot t_b} \rangle \langle I \rangle \langle I \rangle = \frac{1}{(1+t_b)^2}$$

となる。*n* 個のホールをあけた場合は、ホールの 深さは

$$F_f(t_b) - F_h(t_b) = \frac{t_b}{(1+t_b)^{n+1}}$$

となり、これは $t_b = 1/n$ のとき最大値を取る。 すなわち、n 個のホールをできるだけ深くあけよ うと思ったら、1 個のホールの深さが最大となる 照射時間の1/nの時間で各ホールをあければよ い。nが十分に大きい場合、こうしてあけたホー ルの深さは 1/en になる。

参考文献

- A. Kurita, Y. Kanematsu, M. Watanabe, K. Hirata, T. Kushida, Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 1582.
- A. Kurita, Y. Kanematsu, M. Watanabe, K. Hirata, T. Kushida, Proceedings of ICL'99 (in press).
- 栗田 厚、兼松泰男、渡邊正仁、平田久仁子、櫛田 孝司、村瀬至生、矢澤哲夫:光物性研究会'98 論文 集 IA-7 p.25.
- W. E. Moerner, Ed., Persistent spectral holeburning : Science and applications. (Springer-Verlag, Berlin, 1988).
- T.Inada, S.Uchida, Y.Yokoyama, Chem. Lett. (1997) 321.
- J. C. Dainty, Ed., Laser speckle and related phenomena (Topics in applied physics ; v. 9) (Springer-Verlag, Berlin, 1975.)